

学会発表リスト(デバイス工学分野)

(発表者、発表題目、学会名または講演予稿集等の掲載ページ)

Takuma Yo, Hideaki Tanaka, Kenichiro Nakamatsu, Shinji Matsui, Akira Sakai and Junichi Yanagisawa: Nano-indentation Measurement of Carbonaceous Films Formed by Focused Ion Beam-Induced Chemical Vapor Deposition (FIB-CVD) Using Au or Si Ions with Phenanthrene, Abstracts of the 16th International Conference on Ion Beam Modification of Materials, p. 173 (2008)

Takuma Yo, Hideaki Tanaka, Takahiro Nagata, Naoki Fukata, Toyohiro Chikyow, Akira Sakai and Junichi Yanagisawa: Annealing Effect of Deposited Materials Formed by Focused Au or Si Ion Beam-Induced Chemical Vapor Deposition Using Phenanthrene, Digest of Papers of the 21th International Microprocesses and Nanotechnology Conference, pp. 150-151 (2008)

柳沢淳一: 集束イオンビームで形成した多孔質 Ge 表面構造のプラズマ処理による改質の可能性, 電気学会プラズマ研究会 (2008)

楊卓真, 酒井朗, 柳沢淳一: FIB-CVD 法で作製したカーボン系堆積物におけるアニールの影響, 第 56 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集, 746 頁 (2009)

石泉和也, 柳沢淳一, 酒井朗: Ga イオン注入したシリコン窒化膜上への MOCVD による GaN の選択成長, 第 56 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集, 747 頁 (2009)

Junichi Yanagisawa, Hiroaki Kobayashi, Kakunen Koreyama and Yoichi Akasaka: Fabrication of Micro Fluid Channel Structures by Focused Ion Beam Techniques, The MRS 2009 Spring Meeting (2009)

柳沢淳一: 集束イオンビーム支援堆積法で形成したカーボン系薄膜の機械的特性のイオン種依存性, 電気学会プラズマ・パルスパワー・放電合同研究会 (2009)

Junichi Yanagisawa, Kazuya Ishiizumi and Akira Sakai: Surface Modification of SiN<sub>x</sub> to GaN by Ga Ion Implantation to Form a Matrix for Selective Growth of GaN by MOCVD, Abstracts of the 16th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams, p. 38 (2009)

Kazuya Ishiizumi, Jun Kikkawa, Yoshiaki Nakamura, Akira Sakai and Junichi Yanagisawa: Maskless Formation of Patterned Gallium Nitride Layer on Low-Energy Ga-Ion-Implanted Silicon Nitride Surface by Metal-Organic Chemical Vapor Deposition, Digest of Papers of the 22nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference, pp. 182-183 (2009)

柳沢淳一：集束イオンビームによるガラス基板上へのマイクロ流路形成，東北大学金属材料研究所・金研ワークショップ「イオンビームを用いた高機能材料の創製(III)」(2009)

Hideo Takeuchi, Junichi Yanagisawa, Takayuki Hasegawa, and Masaaki Nakayama : Intense emission of THz Electromagnetic Wave from an Undoped GaAs/*n*-type GaAs Epitaxial Layer Structure, Abstracts of the 35th International Symposium on Compound Semiconductors P34 1-2 (2008)

竹内日出雄，柳沢淳一，長谷川尊之，中山正昭：アンドープ GaAs/*n* 型 GaAs エピタキシャル層構造におけるテラヘルツ電磁波増強機構，第 19 回光物性研究会論文集，414-417 頁 (2008)

竹内日出雄：GaN 系エピウエハの光学的評価，応用物理学会関西支部セミナー「光物性とその応用」窒化物半導体の光物性とデバイス (2009)

Hideo Takeuchi, Junichi Yanagisawa, and Masaaki Nakayama : Direction Reversal of the Surface Band Bending in GaAs-based Dilute Nitride Epitaxial Layers Investigated by Polarity of Terahertz Electromagnetic Waves, Abstracts of the 14th International Conference on Narrow Gap Semiconductors and Systems pp. 22-23 (2009)

竹内日出雄，長谷川尊之，柳沢淳一，中山正昭：アンドープ GaAs/*n* 型 GaAs エピタキシャル層構造における高強度テラヘルツ電磁波発生，日本物理学会講演概要集 64 号(2-4)，675 頁 (2009)

Hideo Takeuchi, Junichi Yanagisawa, Jun Hashimoto, and Masaaki Nakayama : Observation and Quantification of the Direction Reversal of the Surface Band Bending in GaAs<sub>1-x</sub>N<sub>x</sub> Using Terahertz Electromagnetic Wave and Photoreflectance Measurements, Abstracts of the 8th International Conference on Nitride Semiconductors Vol. 2 pp. 1110-1111 (2009)

竹内日出雄，橋本淳，柳沢淳一，中山正昭：テラヘルツ電磁波による GaAs<sub>1-x</sub>N<sub>x</sub> の表面バンドベンディング方向の調査と光変調反射分光法を用いた定量化，第 20 回光物性研究会論文集，57-60 頁 (2009)

鶴田修一，竹内日出雄，橋本淳，柳沢淳一，山田永，秦雅彦，中山正昭：*i*-GaAs/*n*-GaAs エピタキシャル構造からのテラヘルツ電磁波発生の層厚依存性，日本物理学会講演概要集 65 号(2-4)，735 頁 (2010)

竹内日出雄，橋本淳，柳沢淳一，中山正昭：GaAs ベース希薄窒化物半導体エピタキシャル層におけるテラヘルツ電磁波の極性反転，日本物理学会講演概要集 65 号(2-4)，805 頁 (2010)

山田逸成，金高健二，西井準治，斉藤光徳：WSiの複素屈折率評価と格子状薄膜の偏光機能予測，第54回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集，1048 頁 (2007)

吉村和浩，山田逸成，斉藤光徳：自己制御型光パルス分岐デバイスの製作，第54回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集 1245 頁 (2007)

山田逸成，金高健二，西井準治，斉藤光徳：WSiワイヤグリッド偏光子の反射防止膜効果の検討，第68回応

用物理学会学術講演会 講演予稿集, 1001 頁 (2007)

Mitsunori Saito, Ryosuke Takeda, Kazuhiro Yoshimura, Ryota Okamoto, and Itsunari Yamada: Optical Gate That Photons Open or Close by Themselves, 20th Annual Meeting of the IEEE Lasers & Electro-Optic Society, ThU4, Proceedings, pp. 854–855 (2007)

Itsunari Yamada, Kenji Kintaka, Junji Nishii, and Mitsunori Saito: Refractive-Index Evaluation of WSi and Its Application to Infrared Wire-Grid Polarizers, 8th International Conference on Mid-Infrared Optoelectronics: Materials and Devices, P40, Program and Abstracts, pp. 188–189 (2007)

Itsunari Yamada, Junji Nishii, and Mitsunori Saito: Grooved Infrared Polarizers with a Reduced Reflectance, SPIE Conference on Smart Structures, Devices, and Systems III, 64141V, Proc. SPIE, vol. 6414, 64141V (2007)

山本達也, 山田逸成, 西井準治, 三原進, 浦野壮, 斉藤光徳: めっき法による埋め込み型ワイヤグリッド偏光子の製作, 第56回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集, 1023 頁 (2009)